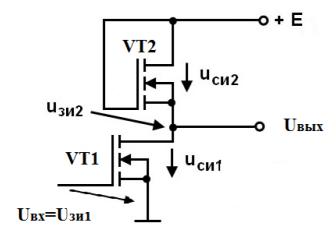
Цифровой ключ на полевом транзисторе

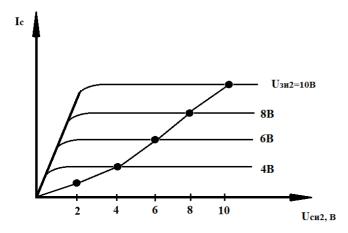
Полевой транзистор, как и биполярный транзистор широко используется в полевых схемах. В цифровом ключе обычно используют МОП транзисторы с индуцированным каналом.

Ключ на МОП транзисторах с динамической нагрузкой

Ключ на МОП транзисторах можно выполнить с резистивной нагрузкой, подобно ключу на биполярном транзисторе. Если ключи на полевых транзисторах выполняются по интегральной технологии то технологически целесообразнее применять так называемую динамическую нагрузку. В качестве нагрузки ключевого МОП транзистора оказывается более выгодно второй МОП транзистор канал которого всегда открыт, а сопротивление канала остаётся почти постоянным.

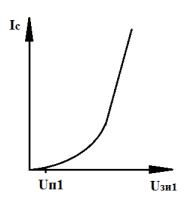


Сток-затворная характеристика



При использовании в цифровых устройствах ключа на МОП транзисторах реализуют функцию инвертора логического элемента ${\rm HE}.$

Вольт-амперная характеристика

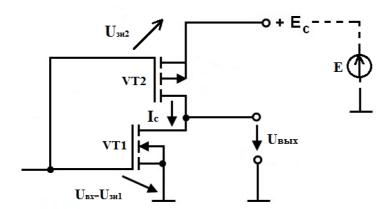


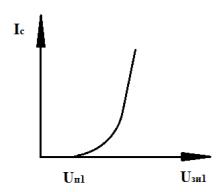
$$U_{\rm ex}^1$$
 $U_{\rm exact}^0$

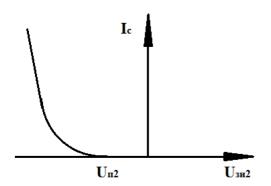
$$U_{\rm ex}^0$$
 $U_{\rm exx}^1$

Ключ на комплементарных МОП- транзисторах КМОП.

Комплементарный/ дополняющий/ подобный - ключ с минимальным потреблением энергии от источника питания, строится на комплементарной паре ПТ (дополняющей дуг друга паре ПТ). Используется два МОП транзистора с одинаковыми характеристиками, но с различным типом проводимости канала. Схема оказывается симметричной, и когда один из транзисторов выполняет роль замкнутого ключа, другой – размокнут и выполняет роль нагрузочного сопротивления и наоброт.







Уравнение по второму закону Кирхгофа.

$$U_{3и2}$$
 - $U_{3и1}$ = - Е

 $\underline{\mathrm{U}_{3u2}} = \underline{\mathrm{U}_{3u1}}$ - $\underline{\mathrm{E}}$ – связь между U_{3u2} и U_{3u1}

1.
$$U_{\rm ex}^1 = U_{\rm 3и1} \quad U_{\rm II} \quad {\rm VT1~otkpыt}, \quad U_{\rm exex}^0 \quad , U_{\rm 3и2} \quad 0, {\rm VT2~sakpыt}, {\rm I_c=0}$$
 2.
$$U_{\rm ex}^0 = U_{\rm 3и1} < U_{\rm II} \quad {\rm VT1~sakpыt}, \, U_{\rm 3и1} \quad 0, \, U_{\rm 3и2} = - \, {\rm E}, \quad U_{\rm exex}^1 \quad {\rm E, \, VT2~otkpыt}$$

Недостатки: во время переключения через транзисторы протекает ток, обусловленный перезарядом собственных емкостей транзисторов и емкостью нагрузки, поэтому с ростом частоты переключения потребление энергии схемы увеличивается. Эти ёмкости относительно велики, и недостатком таких ключей — сравнительно низкая частота переключения.

Ключи на инверторных МОП транзисторах с каналами n, p типа и на комплементарных транзисторах лежат в основе интегральных полевых технологий, соответственно обозначаемых n-МОП, p-МОП и КМОП технологии.

Схемотехника базовых логических элементов

Логические элементы И, ИЛИ, HE — представляют собой основные базовые логические элементы. И-НЕ, ИЛИ-НЕ (ещё базисы). Из таких элементов можно собирать устройства, выполняющие сколь угодно сложные функции.

Для современной цифровой схемотехники характерно широкое использование двух базисов – И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Для их реализации логические элементы строят так, состоящими как бы из двух схемных частей: 1 часть схемы выполняет операцию И или ИЛИ, эта часть схемы входная логика; 2 часть схемы – инвертор, выполняющий операцию НЕ.

Входная логика может быть выполнена на различных элементах, полупроводниковых элементах (диодах, БТ и ПТ). В зависимости от вида полупроводниковых элементов, применяемых для изготовления входной логики и инверторов различают следующие виды:

ДТЛ – диодно-транзисторная логика

ТТЛ – транзисторно- транзисторная логика

ТТЛШ – транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки

ЭМЛ – эмиттерно-связанная логика

ИИЛ – интегрально-инжекционная логика ($И^2Л$)

n-MOΠ

р-МОП

КМОП - комплементарная структура металл-оксид-полупроводник